PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 54-146581 (43)Date of publication of application: 15.11.1979

(51)Int.Cl. H01L 21/66

G01R 31/26

(21)Application number: 53-055134 (71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing: 09.05.1978 (72)Inventor: FUJII TOSHIYUKI

(54) ELECTRIC CHRACTERISTIC MEASURING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR CHIP (57) Abstract:

PURPOSE: To ensure a quick measurement of the characteristics of each chip by providing the measuring needle which features a simultaneous pressure contact to each electrode and the semiconductor chip inserted into the pocket of the container.

CONSTITUTION: A pressure contact is decured for measuring needle 5a and 5b of measurement plate 10a to cathode K and gate G of each semiconductor chip 4 within each pocket 2 of insulating substance 1. At the same time, a pressure contact is given between measuring needle 7 of measurement plate 10b and anode A through the pierced hole of substance 1. Then the connection between each measuring needle and measuring instrument 9 is switched in sequence with every chip 4 to measure the electric characteristics. With this method, the intermittent feeding mechasnism can be omitted, thus ensuring a quick measurement.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

1 of 1 10/26/2007 11:26 AM

(9日本国特許庁(JP)

00特許出願公開

切公開特許公報(A)

昭54-146581

5)Int. Cl.²
H 01 L 21/66
G 01 R 31/26

識別記号 52日本分類 99(5) C 6

7月7919年2日年5 6851—5 F 7807—2 G

庁内整理番号 49公開 昭和54年(1979)11月15日 6851-5F

> 発明の数 1 審査請求 未請求

> > (全 5頁)

50半導体チップの電気的特性測定装置

電機株式会社北伊丹製作所内 加出 願 A = 英爾機株式会社

②特 顧 昭53-55134

勿出 願 人 三菱電機株式会社

20出 願昭53(1978)5月9日

東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 3 号

70発 明 者 藤井利之

19代 理 人 弁理士 葛野信一 外1名

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱

~

男 細 1

1. 発明の名称

半導体チップの電気的特性測定装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

との発射は半みなチップ収容器に収容された複数値の半海体チップの電気的物性を調定する半端 体チップの電気的特性測定装置の改良に関するも のである。

一般に、メサ形サイリスタなどの半海体案子に

かいては、複数個の半導体チップが形成された半 等体ウェーへの状態で上記合半導体ナップの電、 的等性を存物につることができないので、 記分割された個をないではないであり、 との電がの記録をからなる半導体チップ収容器に ないので、 との電がの記録をからなる半導体チップ収容器に 収容して個々ので導体チップで電気的語解性を別 収容し、それで創定を表示して、 食品とに選別している。

第1図は従来のメサ形サイリスタの半導体チップ収容器の一例を示す糾視図、 煎2図は上記従来例の要部を示す断面図である。

図にかいて、(1) セメサ形サイリスタの半導体チ ップ収容器を構成する熱解体である。(2) は純酸解 (4) の表演形式サポサイリスタの半導体チップが折 人されるポケット、(3) セポケット(3) の定面に破却 した、(4) を買過する買過孔、(3) 2 図に破却 です。(4) はメサポサイリスタの半導体チップである。 次に、純軟体(1) の合ポケット(3) に加入された半

特別昭54-146581(2)

導体チップ(4)の電気的特性を測定する従来の測定 装置の動作機械を銀3回に示す断面図で説明する。

図において、 (5a) および (5b) はそれぞれボケ ット(2) 内の半導体チップ(4) のカソード電極 E およ びゲート氧極ほに加圧接触するカソード測定針を よびゲート測定針、(6)はカソード測定針(5a) およ びゲート劉定針(57)が固定され上下準衡可能なカ ソード・ゲート 初定子 (以下「KG 測定子」と呼 ぶ)、(7) はポケット(2) 内の半導体チップ(4)のアノ 一ド電極 A に貫通孔(3)内を通して加圧接触するア ノード 削定針、(8) は ア ノード 測定針(7) が 固定 され 上下運動可能なアノード測定子(以下「A測定子」 と呼ぶ)、(9) はカソード測定針(5a)、ゲート測定 針 (5 b)、およびアノード測定針(7)にそれぞれ接続 され半導体チップ(4)の電気的特性を測定する測定 器である。 なお、 絶様 体(1) は K G 測定子(6) と A 測 定子(8)との中間部に介在し前後左右に各ポケット (2) の相互間の距離づつ間欠送りができるようにな つている。

とのような動作機構を有する測定装置によって

(3)

各ポケット(2) に挿入された半導体チップ(4) の電気 的特性を測定し、それぞれの訓定結果にもとづい て良品と不良品とを選別することができる。

しかしながら、上配制定装置の処理能力の増大 を図るために、絶骸体(1)のポケット(2)の数を多く すると、その数に比例して絶縁体(1)の外形寸法も 大きくなるので、絶縁体(1)の前後左右の間欠送り 機構をはじめとする装置全体の機械精度が低下す るという問題があつた、このために、例えば、ポ ケット(2)の数が 20 × 20 = 400個、ポケット(2)の 相互間の距離が Bmm、絶縁体(1)の外形寸法が 200 mm 角である場合には、 A 都定子(8) のアノード側 安針(7) が专職 たく 派り得る 貫通孔(8) の 許容 器 小孔 径は約 2mmであつたっこのような孔径 2mm の買通 A (a) 内を消してアノード制定針(7) によつて測定さ れる半減休チップ(4)の外形寸法は 3 mm 角以上であ ることが必要であつた。例えば、半導体チップ(4) の外形寸法が2.5mm角以下である場合は、これを ポケット(2)内へ挿入するとき、半導体チップ(4)の 国が首涌孔(3)内に落ち込み破損したり、測定時の

(4)

体チップの電気等性測定装置を提供することを目 的とする。

第4回はこの発明の半導体チップの電気的特性 御定装仮の一実的例の相成とその動作機構とを説明するための断面図である。

図にかいて、(10s) は無無体(1)の名がケット(2) 内に抑入された半端体チップ(4) に同無にそれぞれ のカソード 観触 (1cs) かりよびゲート 利取分 (1cs) かりいた (1cs) かり (1cs) かり (1cs) かり (1cs) が成か (1cs) が (1cs) は (1cs) が (1cs) で (1

ト(2)方の各半導体ナンブ(4)のカソード電板 x とグート電極 g とにせれぞれ誤 1 の勘定子板(1co)とウルードの元分(1co)とグート制定針(1co)とを加圧 が はさせるとともに、 名半導体ナンブ(4)のワナード観転 A にそれぞれ 第 2 の制定子板(10)のアメート の一下 3 受針(2)の と 3 の を 3 の で 3 の で 3 の で 4 の で 4 の で 5 の で 5 の で 5 の で 5 の で 5 の で 7 の で 5 の で 7 の で 7 の で 8 の で 7 (4)の で 8 次 の 5 の で 9 で 9 の 2 の 8 次 4 半導体ナンブ(4)の 6 に 別 次 9 の 8 次 6 な と さ れ 5 っ で 8 半導体ナンブ(4)の 電 気 的 寄性 が 3 に だ た 5 っ で 8 半導体ナンブ(4)の 電 気 的 寄性 が 3 に 2 に れ 5 っ

とのように、この実施例の電気的等性網定映数では、 総縁休(1)の間欠送り横線を設ける必要がないので、 新 2 の別度板(101)のアノート列度針(7)を油し得る買消孔(3)の孔低を小さくすることができるために、外係寸波の小型することができる。 大・年半年休ケップ(6)に接続された測定対 6 0 4 (01)(7)と刻定線(6)との接続を各半期休ケップ(6)

(2)

新出面に同時に加圧接触するアノード測定針のと が取り付けられた舞るの測定子板である。

絶無体(1)の各ボケット(2)内に押みされた単場体 ナップ(4)の電気的特性を制定する場合には、この 半端年ナップ収容器と誤るの制度子板(10c)とを 対向させ、熱験体(1)に設けられた各制変端子の、 各ボケット(2)内の半端体チップ(4)のカソード電板 ス、およびゲート程限のにそれぞれ視るの測定子 板(10c)のフノードが宏針(7)、カソード制定針(8)、 およびゲート制度針(5s)を加圧接折させる。しか るのち、各半端体チップ(4)がにアノード制定針(7)、 カソード制定針(5s) とかまびゲート制定針(10s) と 列域(10c)の形気的発性が測定される。 環体チップ(4)の影気的発性が測定される。

この実施例の電気的特性測定狭隘では、各ポケット(3)の底態に実過孔を設ける必要がないので、 第4回の実施例より外形寸法の一層小さい 中部人 チップでもその電気的特性を容易に鞭定 すること なできる上に、第4回に説明した第2の測定すること (10c)が不要になるので、第4回の実施例よりそ 特に顧衣切り換えてそれぞれの電気的寄性を削定することができるので、開欠送りに多する時間が必要ですく、削定時間の短額を図ることができる。例えば、20×20=400 何のボケットを有する中様体ナップ収容器のそれぞれのボケットに挿入された単導体ナップの電気的発性を全数測定するのに対しては16分必要であったのに対し、2分別内にできるように受動することができた。

飯5図はこの発明の他の実施例の構成とその動作機構とを説明するためにその要部を示す断面図である。

図において、時は乾燥体(小)の色ボケット(2)の相 互補の表面に貸出版を有するようれ一次の 競牌子、 はは乾燥体(1)に 表設 された方の 然かット(3)の底面に無しな力の繰かが各制定効 子切に統裁 された 包気的 帯電性のよい 導体、 (100) は各ボケット(3)内に加入された半導体チップ(4)に 同時にそれぞれのカソード 製盤 オースカソート 観 似 g に 同時にそれぞれか 圧 契係 オースカソート 制定 似 g に 同時にそれぞれか 圧 契係(5) よと 観 変 が アート 制定 (5) およ びゲート 制定 契 (5) と と 観 鬼 郊 鬼 郷 第一300

(8)

の構造を簡単化することができる。また、第 ◆ 図 に散明した実施例と阿様に、領定時間の短網を図 ることができることは言うまでもない。

次に、上記実施例の数像によつて半導体チップ の食品と不良品とが進別されその不良品を除去す る方法について錦6回に要部を示す財面配で設明 ナス。

図において、いは実空装策に真空パルプ(図示せず)を介して接続され、との実空パルプの開放 によって軽緑体(1)のポケット(3)内から半導体チップ(4)を製引する真空テャック、00は能験体(1)の冬 ポケット(3)と列応する略位に実空チャック間を面 別でも真空チャック固定板である。

 る。しかるのち、総縁体(1)の名ボケット(3)内の中 現体チップ(4)の負品と不良品とを配権する配権が 数の指令によって、半導体チップ(4)の不良品が 及されているボケット(9)上に位置すると、半導 人されているボケット(9)上に位置すると、半導 体チップ(4)の不負品のみが実空バルブ切に吸引さ れてこれらの不負品を容易に除去することができ る。

なお、これまで、メサ形サイリスタの半導体チップについて設明したが、この他の半導体案子の 半導体チップにも適用することができる。

以上、契則したように、この発明によれば、主 国に複数性の電極を有する単導体やフブが換えさ れる複数性の増極を有する単導体の要面に整列とした 一般では大学場体ナツブ収容器と上配合ボケツトに 挿入された単場体ナツブ収容器と上配合ボケマトにの 毎鬼種に同時にそれぞれ加圧接触する測定針が取 り付けられた測足子取とを偏支に、半場体チップ 個にそれぞれの各電磁に加圧兼触する制度針のの 接続できれぞれの各電磁に加圧兼触する制度針のの 接続でランプの

(11)

図において、(i) 性能核体、(i) はポケット、(i) は 買適孔、(i) は半導体チップ、(5 c), (5 c), (7) はそ れぞれ制定針、(i) は x o 制定子、(i) は A 動定子、 (i) は 割定数、(10 c), (10 b)、 かよび (10 c) はそれ ぞれ刻 1、 無 2、 かよび第 3 の 耐定子板、 i) は 制 関 滑子、 ip は 調体 、 ip は 某空テャック、 i) は 其空 テャック 画定数である。

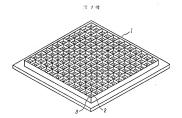
なお、医中間一符号はそれぞれ同一もしくは相 当部分を示す。

代理人 葛 町 信 一(外1名)

を朝途するので、従来例のように、上記半導体・
ップ収容器の間欠選り機器を設ける必要がない。
このために、上記半導体・
ップ収容器の間欠選り機器を設ける必要がない。
このために、上記半導体チップの散気的特性の制 定時間を想配することができるととをに、外括寸 法のつよい半線体チップでもその電気的特性を当 易に観覚することができる。

4. 図面の簡単な説明

ńα



m 2 w

